



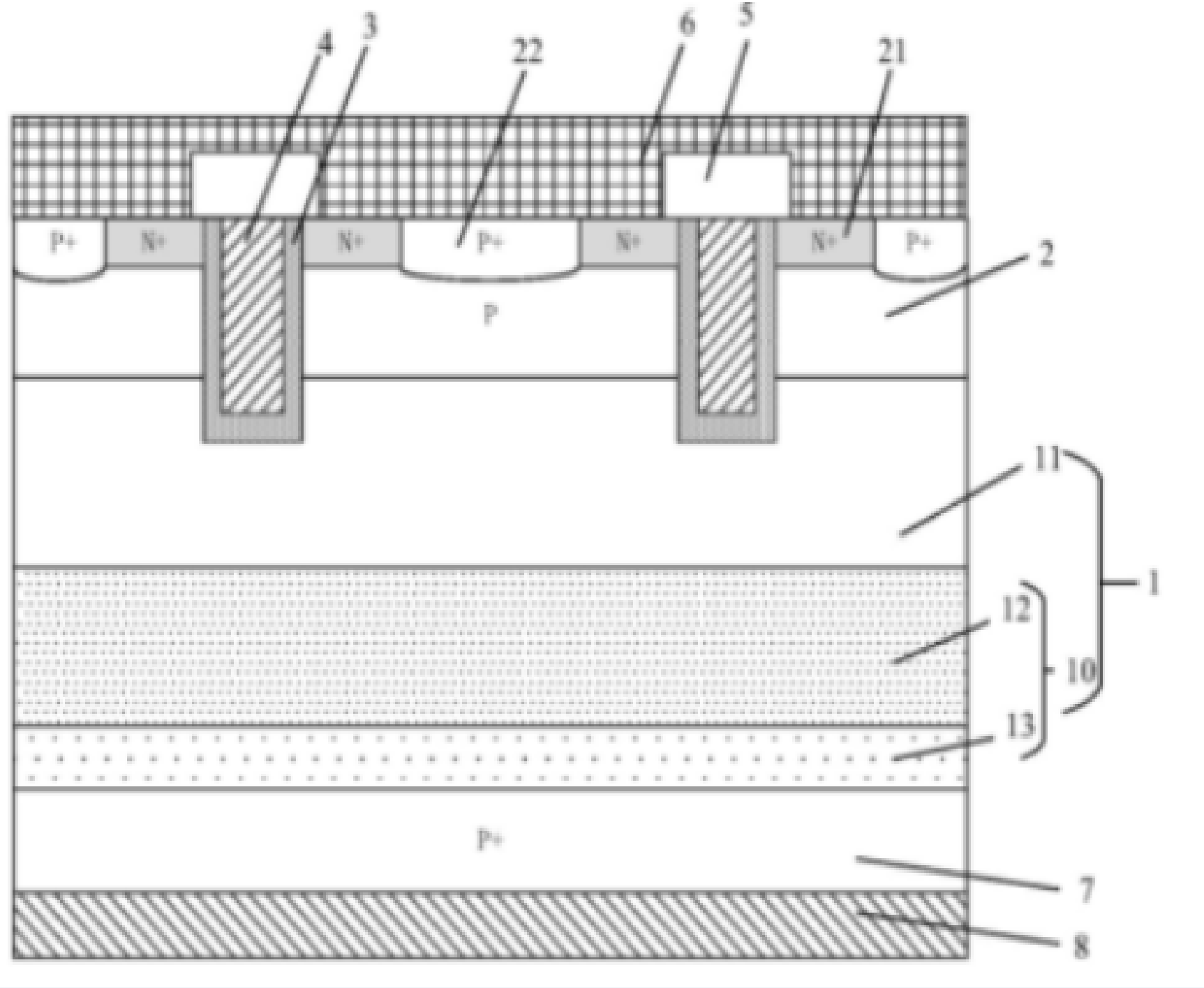
华为公开“半导体器件”相关专利

编译者：husisi 发布时间：2021-7-12 点击量：48 来源栏目：企业动态



近日，据天眼查显示华为技术有限公司公开“半导体器件及相关模块、电路、制备方法”专利，公开号CN113054010A，申请日期为2021年2月。

专利摘要显示，本发明实施例公开了一种半导体器件及相关模块、电路、制备方法，该器件包括：N型漂移层、P型基极层、N型发射极层、栅极、场截止层和P型集电极层等，其中，场截止层包括依次层叠于N型漂移层的表面的第一掺杂区和第二掺杂区，第一掺杂区的杂质的粒子半径小于第二掺杂区的杂质的粒子半径，第一掺杂区和第二掺杂区的掺杂浓度均高于N型漂移层的掺杂浓度。上述半导体器件，可以有效降低IGBT的集电极与发射极之间的漏电流。



据悉，IGBT技术多用于功率半导体，对于华为而言，在其汽车研发和光伏逆变器等产品上要用IGBT技术。有业内人士认为，在功率器件中，进行多次外延，在衬底的基础上增加不同掺杂元素和不同厚度的外延层，用于改善极间漏电流。

来源机构 Ofweek-电子工程网

原文题目 华为公开“半导体器件”相关专利

原文来源 <https://ee.ofweek.com/2021-07/ART-11000-2801-30508370.html>

上一篇：[Cirrus Logic宣布同意收购Lion Semico...](#)

下一篇：[传安世半导体将斥资8700万美元收购英...](#)

提供服务： [导出本资源](#)

相同栏目

相关资源

- 1 海信激光电视激战大屏电视...
- 2 “国产芯”再添新突破！云...
- 3 海信祭出价格杀手锏 激光...
- 4 现代摩比斯计划2020年前...
- 5 东湖高新区赴沪招商 近20...
- 6 镭神智能发布激光雷达专用...
- 7 极米皓LUNE发布：重新定...
- 8 德国激光巨头通快集团200...
- 9 NASA即将推出测绘全球森...
- 10 地平线公司推出自动驾驶芯...

热门资源

最新资源

- 1 光通讯发展要更快，谷歌的...
- 2 未来五年3D打印将如何发...
- 3 西安光机所片上集成光源方...
- 4 苏州纳米所等在碳气凝胶研...
- 5 国内光纤激光器市场现同质...
- 6 中国用世界最快计算机创造...
- 7 LED产业十三五规划出炉 设...
- 8 英特尔人工智能加速眼科诊...
- 9 落实提速降费新举措 六模...
- 10 欧司朗购入激光雷达公司Le...